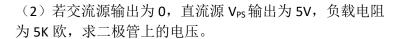
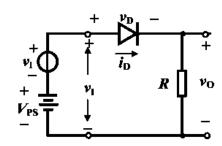
## 模拟与数字电路作业(一)

- 1. 采用二进制补码完成计算: 25-73, 写出计算过程与二进制/十进制结果。
- 2. 某二极管的按照右图方式与一个直流源、一个交流源、 一个电阻连接。
- (1) 假设二极管采用折线模型,截止电压为 0.6V,导通区等效电阻为 0.05 欧,请画出二极管伏安特性曲线。



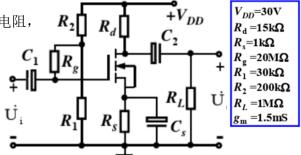


(2) 若图中交变电源为 v<sub>i</sub>=0.1sin(wt) (单位:伏),求二极管上的交流电压的幅度。

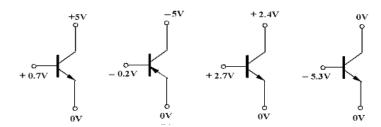
3. 在下图所示电路中,已知 MOS 管工作在饱和区 电路具体参数见蓝色框内,求:

(a) 该电路的小信号增益, 高频输入电阻与输出电阻,

(b) 画出该电路的小信号模型。



4. 下图所示为四个晶体管所在电路测得的电压, 试判断各三极管的工作状态, 并说明理由。



5. (仿真题)已知下图所示放大电路,根据仿真其中给定的 CMOS\_035\_Spice\_Model 文件进行仿真,将 NMOS 管的宽长比(W/L)<sub>T1</sub> 设为 15; PMOS 管的宽长比(W/L)<sub>T2/T3</sub> 设置为 30。令电源电压  $V_{\rm DD}$ =3.3V。

试用用仿真软件分析:

- (1)设计一个晶体管输入、输出伏安特性曲线测试电路,通过直流扫描(.dc sweep)仿真得到特性曲线,并估算 MOS 管的  $K_n$ , $V_t$ 等系数。
- (2)为了令  $I_{REF}$  的电流为 0.2 mA ,将电流源替换成一个电阻  $R_{REF}$  ,求其阻值,并通过仿真验证,比较设计值与仿真值的差别;
- (3)通过直流扫描(.dc sweep)电压传输特性曲线  $v_0 = f(v_I)$ ,并求当  $v_0$  位于  $0.5V_{DD}$  时对应的  $v_I$  值;
- (4) 当输入直流电平在 1V 时, 计算的直流静态工作点、小信号电压增益, 并与时序仿真(小信号正弦波.tran 输入)结果比较。

